
	<h2>SIHU7N60E-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHU7N60E-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p> <p>Datenblätter:  SIHU7N60E-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



Spezifikationen

Teilenummer	SIHU7N60E-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7A TO-251
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7A (Tc) 78W (Tc) Through Hole TO-251
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

SIHU7N60E-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU7N60E-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU7N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHU7N60E-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHU6N62E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 620V 6A TO-251</p>	 <p>SIHW23N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 23A TO-247AD</p>	 <p>SIHU7N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p>	 <p>SIHU6N62E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 620V 6A TO-251</p>
 <p>SIHU7N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p>	 <p>SIHW23N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 23A TO-247AD</p>	 <p>SIHU6N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p>	 <p>SIHU6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-251</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHU7N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHU7N60E-E3 Datenblatt	SIHU7N60E-E3-Datenblätter	SIHU7N60E-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHU7N60E-E3
SIHU7N60E-E3 Electronic	SIHU7N60E-E3-Komponenten	SIHU7N60E-E3-Verteiler	SIHU7N60E-E3-Bild	SIHU7N60E-E3-Teil
SIHU7N60E-E3 Preis	SIHU7N60E-E3 Hersteller	SIHU7N60E-E3 Bild	SIHU7N60E-E3 Aktie	SIHU7N60E-E3 Inventar
SIHU7N60E-E3 Neu	SIHU7N60E-E3 Original	SIHU7N60E-E3 garantiert	SIHU7N60E-E3 RFQ	SIHU7N60E-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited